DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014592083 **Image available**

WPI Acc No: 2002-412787/200244 XRAM Acc No: C02-116663

XRPX Acc No: N02-324288

Fabrication of full color organic electro luminescent device to form red, green, and blue sub-pixels simultaneously by co-evaporation process using

low protection mask and high protection mask

Patent Assignee: IND TECHNOLOGY RES INST (INTE-N); CHANG E (CHAN-I); CHAO C

(CHAO-I); HSIEH C (HSIE-I); TSAI R (TSAI-I)

Inventor: JANG E; JAU C; SHIE J; TSAI R; CHANG E; CHAO C; HSIEH C

Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

TW 451601 A 20010821 TW 2000115831 A 20000807 200244 B

US 6517996 B1 20030211 US 2000715527 A 20001117 200314 US 20030118950 A1 20030626 US 2000715527 A 20001117 200343

US 2000/1332/ A 2000111/ 2003

US 2002310590 A 20021204

Priority Applications (No Type Date): TW 2000115831 A 20000807

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

TW 451601 A H05B-033/10 US 6517996 B1 H01J-009/227

US 20030118950 A1 H01J-009/227 Div ex application US 2000715527

Div ex patent US 6517996

Abstract (Basic): TW 451601 A

NOVELTY - Fabrication of full color organic electroluminescent device is disclosed, wherein the full color organic electroluminescent device is formed on the Indium-tin oxide (ITO) glass substrate. The method comprises: form patterns on the ITO glass substrate by microlithography process and clean up the surface of ITO glass substrate. Form an insulating pad on the ITO glass substrate. Form low protection mask and high protection mask by dry film photoresist process respectively, form hole conduction layer by evaporation process, form red, green, and blue sub-pixels simultaneously by co-evaporation process using low protection mask and high protection mask as the barrier. Form an electron conduction layer and metal layer by evaporation process. In the design of the processing machine, the substrate does not rotate in the film-coating process, the substrates are transferred piece by piece continuously by a conveyer belt, individual film-coating work is performed when they pass through the upper opening of the cavity of different film-coating materials. DwgNo 1/1

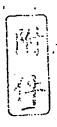
Title Terms: FABRICATE; FULL; COLOUR; ORGANIC; ELECTRO; LUMINESCENT; DEVICE; FORM; RED; GREEN; BLUE; SUB; PIXEL; SIMULTANEOUS; CO; EVAPORATION; PROCESS; LOW; PROTECT; MASK; HIGH; PROTECT; MASK

Derwent Class: L03; P81; U14; V07; X26

International Patent Class (Main): H01J-009/227; H05B-033/10

International Patent Class (Additional): G02F-001/03

File Segment: CPI; EPI; EngPI



中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 451601

[44]中華民國 90年 (2001) 08月 21日

發明

26頁

[51] Int.Cl ⁰⁶: H05B33/10

G02F1/03

WCF 6517.096

[54]名 稱:全彩有機電激發光元件之製作方法

[21]申請案號: 089115831

[22]申請日期:中華民國 89年 (2000) 08月 07日

[72]發明人:

趙清煙

謝佳芬

新竹縣竹東鎮民族路五十巷十五號八樓

台南市西門路一段三八〇巷二弄三十六號

林園縣龜山鄉樂蕃村長庚醫護新村四二一號九樓

蔡榮源 1711申請人:

財團法人工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段一九五號

1741代理人:

1

[57]申請專利範圍:

一種全彩有機電激發光元件的製作方法,用以在一數錫氧化玻璃基板上形成該全彩有機電激發光元件,該方法包括:

圖案化該 數錫氧化玻璃基板:

清潔圖案化之該姻錫氧化玻璃基板表 面:

形成一絕緣墊於該銦錫氧化玻璃基板 上:

以一乾膜光阻製程形成複數個低保護 罩幕之圖案:

以一乾膜光阻製程形成複數個高保護 罩幕之圖案:

以一第一蒸鍍製程形成一電洞傳導 層:

以該些低保護罩幕及該些高保護罩幕 為阻障,以一第二蒸鍍製程同時形成 複數個紅色、綠色及藍色次位素;

以一第三蒸鍍製程形成一電子傳導。

層;以及

2

以一第四蒸鍍製程形成一金屬層。

- 2.如申請專利範圍第1項所述之全彩有機 電激發光元件的製作方法,其中形成 該絕緣墊的材質為係選自由氮化砂及 氫化矽所組成之族群中的任意組合。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之至彩有機 電激發光元件的製作方法,其中該低 保護環幕的厚度為1 微米至10 微米。
- 4.如申請專利範圍第1項所述之全彩有機 10. 電激發光元件的製作方法、其中該高 保護罩幕的厚度為5微米至100微米。
 - 5.如申請專利範圍第1項所述之全彩有機 電激發光元件的製作方法,其中該電 洞傳導層的材料為氦,氦,要苯基-氧、氦,(間、用苯苯)聯苯胺。
- - 6.如申請專利範圍第1項所述之全彩有機 電激發光元件的製作方法,其中該電 洞傳導層的學度為30毫微米至100毫 微米。
- 20. 7.如申請專利範閱第1項所述之全彩有機

5.

5.

15.

20.

FROM SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO..LTD. 2004年 1月30日(金)11:05/管積11:03/文書母号6005173526 P

3

電激發光元件的製作方法,其中該共 蒸鍍製程所使用之藍光之材料為二苯 駢。

- 8.如申請專利範圍第1項所述之全彩有機 電激發光元件的製作方法,其中該些 紅色、綠色及藍色三原色之次位素的 厚度為30毫微米至100毫微米。
- 9.如申請專利範圍第1項所述之全彩有機 電激發光元件的製作方法,該共蒸鍍 製程包括一藍光材料蒸簸源、一紅光 接雜蒸簸源及一綠光邊雜蒸鍍源。
- 10.如申請專利範圍第1項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,其中形 成該些紅色、綠色次位索包括一紅光 接雜物與一綠光接雜物三-(8- 羥基喹 啉)鋁。
- 11.如申請專利範圍第9項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,其中紅 光接雜蒸鍍源及該綠光接雜蒸鍍源分 別位於該藍光材料蒸鍍源之兩側。
- 12.如申請專利範圍第9項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,形成該 些藍光次位素的方法包括該藍光材料 蒸鍍源對該銦錫氧化玻璃基板之正面 蒸鍍。
- 13.如申請專利範圍第9項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,其中該 紅光接雜蒸鍍源及該綠光接雜蒸鍍源 分別以一斜角由兩邊對該銦錫氧化玻 璃基板同時進行蒸鍍。
- 14.如申請專利範圍第12項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,該斜角 為15度至80度。
- 15.如申請專利範圍第11項所述之全彩有機電激發光元件的製作方法,該紅光 接雜物與該綠光接雜物的含量控制在 百分之0.1至百分之10之間。
- 16.如申請專利範圍第1項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,該第四 蒸鍍製程包括了一斜角蒸鍍。

- 17.如申請專利範圍第16項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,該斜角 蒸鍍的角度為5度至60度。
- 18.如申請專利範圍第1項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,其中形 成該金屬層的材質係選自由鈣金屬、 錢金屬、鋰金屬、鋁金屬及銀金屬所 組成之族群中的任意組合。
- 19.如申請專利範圍第1項所述之全形有 10. 機電激發光元件的製作方法,其中該 金屬層包括一鎂金屬層及一銀金屬 層・
 - 20.如申請專利範圍第19項所述之全彩有 機電放發光元件的製作方法,其中該 鎂金屬層厚度為10毫微米至100毫微 米。
 - 21 如申請專利範圍第 19項所述之全彩有機電激發光元件的製作方法,其中該銀金屬層厚度為 150 毫微米至 500 毫微米・
 - 22.如申請專利範圍第1項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,其中該 金屬層為一負電極。
- 23.如申請專利範圍第1項所述之至彩有 25. 機電激發光元件的製作方法,其中該 銦錫氧化玻璃基板為一正電極。
 - 24.如申請專利範圍第1項所述之全彩有 機電激發光元件的製作方法,其中該 絕緣電的厚度為5微米至200微米。
- 30. 25.一種適用於以保護罩幕製程製造全彩 有機電激發光元件的蒸鍍設備,該設 備包括:

複數個蒸鍍源組,每一該些蒸鍍源組 至少包括一個蒸鏡源,該些蒸鏡源組 分別適用於各種材料屬之蒸鍍製程;

- 35. 分別適用於各種材料層之蒸鍍製程: 複數個卡匣座,每一該些卡匣座適用 於承載一銦錫氧化玻璃基板:
 - 一傳輸帶,帶動該些卡匣座,將每一 該些卡匣座上承載的該翅錫氣化玻璃 牡坛床序傳送至該此茲德茲組進行的
- 40. 基板依序傳送至該些蒸簸源組進行復·

10.

6

2004年 1月30日(金)11:05/替積11:03/文書番号6005173526 P

數個蒸鍍製程且在該些蒸鍍製程的過程中該輸送帶不停止傳送的動作。

5

26.如申請專利範圍第25項所述之適用於以保護罩幕製程製造全彩有機電激發光元件的蒸鍍設備,每一該些蒸鏡源組均包括一開口,該開口的長度與該 銦錫氧化玻璃基板的寬度相當。

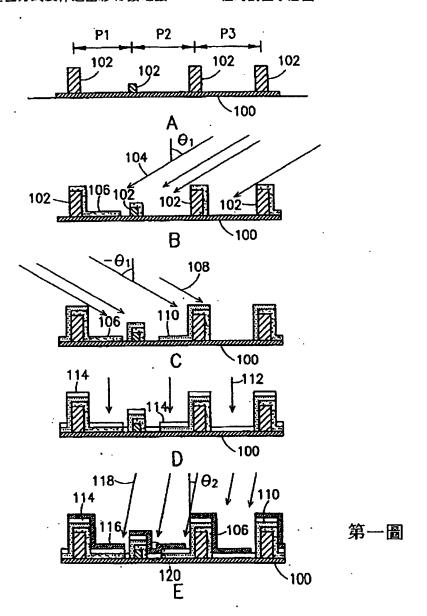
圖式簡單說明:

第一圖 A 至第一圖 E 保繪示習知一 種以 X-Y 定位方式製作之全彩有機電激 發光元件製程的剖面示意圖:

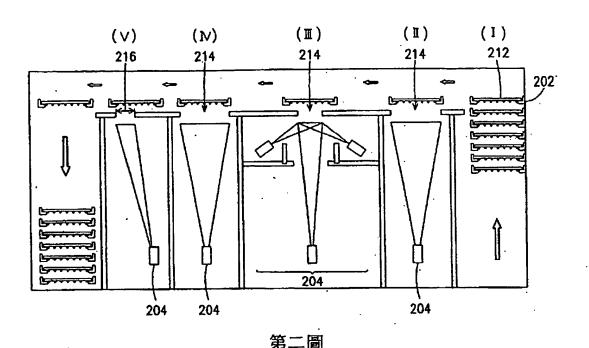
第二**圖係給**示根據本發明之至彩有 機電激發光元件製作方法的製程機台:

第三圖係繪示根據本發明較佳實施 5. 例所提供之6×6畫案之簡單陣列的被動 驅動顯示面板俯視示意圖;以及

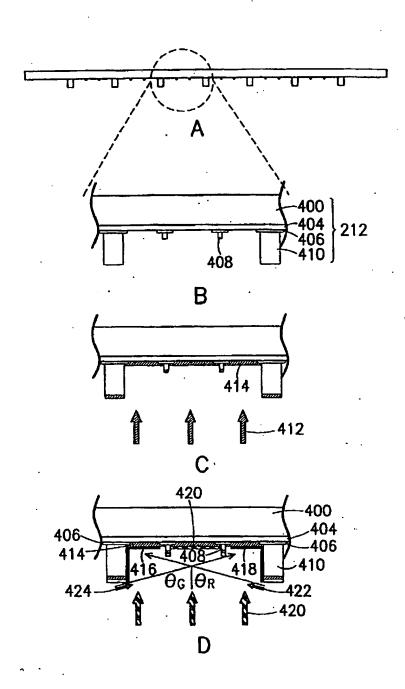
> 第四國 A 至第四圖 G 係給示根據本 發明較佳實施例所提供之一種以 X-Y 定 位方式製作之全彩有機電激發光元件製 程的剖面示意圖。



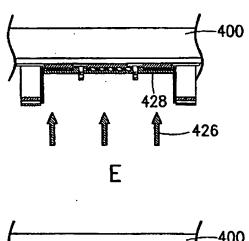
FROM SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. 2004年 1月30日(金)11:06/管積11:03/文書番号6005173526 P

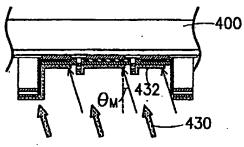


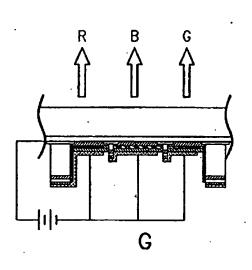
第三圖



第四圖







第四圖